

## บทที่ 5

### สรุป วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปและวิจารณ์ผลการคำนวณ

ในการหาค่าความหนาแน่นประจุพาหะของสารกึ่งตัวนำใน 2, 1 และ 0 มิติ เริ่มจากวิธีการคำนวณที่เหมือนกับ 3 มิติ พบว่าความหนาแน่นประจุพาหะในตัวของสารกึ่งตัวนำใน 2, 1 และ 0 มิติ เกิดจากผลรวมของความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าระดับพลังงานนำและความหนาแน่นของโฮลที่มีพลังงานต่ำกว่าระดับพลังงานเวเลนซ์ โดยความหนาแน่นของประจุพาหะยกตัวอย่างเช่น ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน  $n_D \propto T^{D/2} \sum_{n=0}^{\infty} \exp[(\mu - E_{c_n})/k_B T]$  เป็นผลรวมของความหนาแน่นอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงาน ( $n_D^{(n)}$ ) เทียบกับระดับพลังงานศักย์อ้างอิง  $\mu$  นั่นคือ ที่ระดับพลังงานสูงๆ ค่าของ  $n_D^{(n)}$  จะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานจากสนามไฟฟ้าหรือแหล่งที่ให้พลังงานภายนอก ก็จะถูกกระตุ้นข้ามช่องว่างพลังงาน  $E_g$  ขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงาน  $E_{c_n}$  โดยธรรมชาติที่ระดับพลังงานต่ำๆ ก็จะต้องมีจำนวนอนุภาคในสถานะมากกว่าที่พลังงานสูงๆ ทำให้  $n_D^{(n)}$  ลดลงที่ระดับพลังงานสูงๆ ทำนองเดียวกันสถานะที่เกิดโฮลก็สัมพันธ์กับความสามารที่จะดึงอิเล็กตรอนวงในออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระย่อมมีโอกาสน้อยกว่าที่จะดึงอิเล็กตรอนวงนอก ทำให้ที่ระดับพลังงานใกล้ๆ  $E_c$  และ  $E_v$  มีค่า  $n_D^{(n)}$  และ  $p_D^{(n)}$  สูง

สำหรับกรณีพิเศษ ให้ผลของ  $n_D^{(n)}$  และ  $p_D^{(n)}$  มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ  $E_c$  และ  $E_v$  หรือประมาณว่าอิเล็กตรอนอยู่เฉพาะระดับพลังงาน  $E_c$  และมีโฮลอยู่เฉพาะระดับพลังงาน  $E_v$  จะทำให้รูปแบบของสมการง่ายขึ้น ทำให้ได้ว่าความหนาแน่นประจุพาหะในตัวของสารกึ่งตัวนำมีค่าเป็น  $n_{i,D} \propto T^{D/2} \exp(-E_g/2k_B T)$  ซึ่งขึ้นกับมิติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทอมของ  $T^{D/2}$  มีผลต่อค่าของ  $n_{i,D}$  น้อยกว่าเทอม  $\exp(-E_g/2k_B T)$  มาก ทำให้ในทุกมิติสารมีแนวโน้มของ  $n_i$  ขึ้นกับอุณหภูมิในรูปแบบของแนวโน้มที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ถ้าทุกมิติมีแนวโน้มของ  $n_i$  เหมือนกันก็แสดงว่ามิติแทบจะไม่มีผลอะไรเลย และจากกรณีพิเศษนี้ ทำให้ทราบว่าค่าของ  $\mu$  และ  $E_g$  ขึ้นกับมิติด้วย คือ  $\mu = E_c - \frac{1}{2} E_g + \frac{D}{4} k_B T \ln \frac{m_h}{m_e}$  สำหรับสารกึ่งตัวนำที่ถูกเจือก็มีวิธีการทำนองเดียวกับ 3 มิติ คือ เมื่อเติมสารเจือแล้วจะทำให้ค่า  $\mu$  ของสารกึ่งตัวนำเปลี่ยนแปลงไป แต่จากความรู้เกี่ยวกับความหนาแน่นของสถานะทำให้ทราบว่ามิติมีผลกระทบต่อสถานะของประจุพาหะอย่างมาก ทำให้พบว่าจะต้องมีอิเล็กตรอนและโฮลครอบครองระดับพลังงานย่อย  $E_{c_n}$  และ  $E_{v_n}$  ระดับพลังงานย่อยเหล่านี้เองที่ทำให้  $n_{i,D}$  แตกต่างจาก 3 มิติ

จากการคำนวณความนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำโดยวิธีแบบจำลองของอิเล็กตรอนอิสระ พบว่ามีความนำไฟฟ้าของประจุประจุเช่น อิเล็กตรอน เป็น

$G_{D,e} \propto G_{0,e}(T) T_{KG,e} \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \chi_D \exp[-\Delta_n / k_B T])$  ซึ่งมีรูปแบบเป็น Partition Function เหมือนกับ  $n_D$  เนื่องจากแบบจำลองนี้สมมติว่าค่าสัมประสิทธิ์การทะลุผ่าน  $T_{KG,e}$  มีค่าเท่ากันในทุกระดับพลังงาน  $E_{c_n}$  ทำให้ค่าความหนาแน่นประจุพาหะในตัวแสดงรูปแบบของค่าความนำไฟฟ้า และค่าสัมประสิทธิ์การทะลุผ่านแสดงค่าของความนำไฟฟ้าว่ามีอย่างน้อยเพียงใด ค่าสัมประสิทธิ์การทะลุผ่าน  $T_{KG}$  แสดงความสามารถในการนำไฟฟ้า ถ้า  $T_{KG}$  มีค่าเท่ากับ 1 จะเป็นกรณีในอุดมคติ นั่นคือ สารกึ่งตัวนำที่อุณหภูมิ  $T$  มีค่าความนำไฟฟ้ามากที่สุด และเมื่อค่า  $T_{KG}$  ลดลงก็就会有ค่าความนำไฟฟ้าลดลงด้วย รูปที่ 4.3 แสดงความแตกต่างระหว่าง 3 มิติ ซึ่งค่าความนำไฟฟ้ามีค่าต่อเนื่อง กับใน 2, 1 และ 0 มิติ อย่างไรก็ตามแบบจำลองนี้ยังบ่งบอกความแตกต่างของ 2, 1 และ 0 มิติได้ไม่ดัดนัก ตัวแปรที่บ่งบอกความแตกต่างคือ จำนวนสถานะที่มีพลังงานซ้ำกัน  $n_c, n_v$  และ  $T_{KG}$  ทำให้รูปร่างของกราฟในรูปที่ 4.3 เปลี่ยนไปจากเดิม ในทำนองเดียวกันค่าความนำไฟฟ้าของประจุพาหะโฮลก็มีรูปแบบคล้ายกับรูปที่ 4.3 ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่สมมาตรกัน

เมื่อพิจารณาผลกระทบจาก Nonequilibrium Distribution Function และ Mass Tensor ที่มีต่อค่าความนำไฟฟ้า ทำให้สภาพนำไฟฟ้าของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่  $n$  อยู่ในรูปแบบของ Conductivity Tensor ดังสมการ 4.15 โดยที่มี Mass Tensor แสดงถึงอันตรกิริยาระหว่างระดับพลังงาน  $n$  และ  $n'$  ดังสมการ 4.16 โดยกระทำกับโอเปอเรเตอร์ของความเร็ว  $-iV$  สำหรับกรณีประจุพาหะอิสระก็จะไม่มีอันตรกิริยาระหว่าง  $n$  และ  $n'$  ทำให้  $M^{-1}(\vec{k})$  เหลือเพียง  $(1/m)\delta_{\mu\nu}$  และสมการที่ 4.14 ก็จะคล้ายกับแบบจำลองของอิเล็กตรอนอิสระ จะเห็นว่าผลของอันตรกิริยาระหว่างระดับพลังงานที่  $n$  และ  $n'$  ทำให้  $\vec{\sigma} = \sum_n \vec{\sigma}^{(n)}$  เป็นเมตริกซ์ที่ทำการแปลงระหว่างความ

หนาแน่นกระแส  $j$  และสนามไฟฟ้าภายนอก  $\vec{E}$  ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของเมตริกซ์เป็น  $j_\mu = \sigma_{\mu\nu} E_\nu$

พิจารณา  $\tau_n(\epsilon(\vec{k}))$  ซึ่งขึ้นกับระดับพลังงาน บ่งบอกถึงระยะเวลาที่ประจุพาหะที่อยู่ในระดับพลังงาน  $n$  ใช้ในการเคลื่อนที่ระหว่างการชนหรือมีอันตรกิริยากับพลังงานศักย์อื่นๆ ในแต่ละครั้ง  $\tau_n(\epsilon(\vec{k}))$  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Elastic Relaxation Time ที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมในผลึกและ Inelastic Relaxation Time ที่เกิดจากอิเล็กตรอนกับช่องว่างที่อะตอมหายไปหรืออะตอมอื่นที่เจือปนอยู่ในผลึก (Impurity-Electron Interaction) และอันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอน (Electron-Electron Interaction) โดยมีรูปแบบดังสมการ 4.18 และสมการ 4.20 ตามลำดับ ค่าของ Inelastic Relaxation Time แตกต่างกันในแต่ละมิติสมมติว่าบ่อพลังงานศักย์มีฟังก์ชันเป็น  $U = -\alpha\delta(\vec{k} - \vec{k}')$  พบว่า  $\frac{1}{\tau_{in}(\vec{k})} \propto \alpha^2 N_{im}^D$  นั่นคือ เมื่อค่ามิติ  $D$  ยิ่ง

